

# ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ

## Кремниевый эпитаксиально - планарный импульсный полупроводниковый диод

**2Д510А/ББ**

АЕЯР.432120.239 ТУ

### Особенности

- металлостеклянный корпус КД-3 ГОСТ 18472.

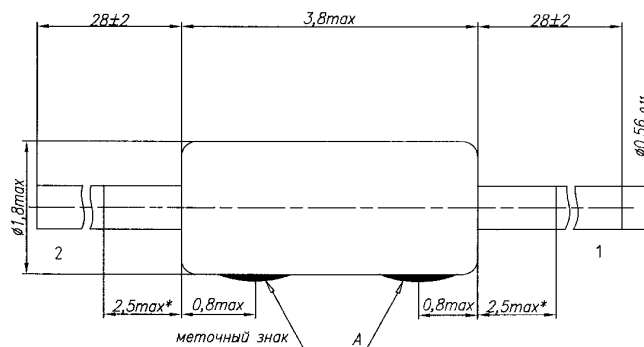
### Применение

- предназначен для работы в импульсных схемах (в импульсных вторичных источниках питания, в преобразователях частоты и т.п.) аппаратуры военного назначения.

### Предельно допустимые значения параметров

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма не более
Максимально допустимое постоянное обратное напряжение, В	$U_{обр.мах}$	50,0
Максимально допустимое импульсное обратное напряжение диода при длительности импульса не более 2 мкс и скважности не менее 10, В	$U_{обр.и.мах}$	70,0
Максимально допустимый средний прямой ток, мА: - при температуре окружающей среды от минус 60 до 50°C; при температуре окружающей среды 125°C	$I_{пр.ср.мах}$ $I_{пр.ср.мах}$	200,0 100,0
Максимально допустимый постоянный прямой ток, мА: - при температуре окружающей среды от минус 60 до 50°C; - при температуре окружающей среды 125°C	$I_{пр.мах}$ $I_{пр.мах}$	200,0 100,0
Максимально допустимый импульсный прямой ток при длительности импульса не более 10 мкс без превышения $I_{пр.ср.мах}$ , мА: - при температуре от минус 60 до 50°C; - при температуре 125°C	$I_{пр.и.мах}$ $I_{пр.и.мах}$	1500,0 500,0
Ток перегрузки (ударный ток), А: - при длительности импульса не более 10 мкс и скважности импульсов не менее 50; - при температуре окружающей среды 25 °C	$I_{уд}$ $I_{уд}$	2,0 2,0
Температура перехода, °C	$T_j$	150

### Габаритный чертеж



1. Маркировать поверхность А - точкой Ø1,2-0,6, красной эмалью ЭП-572 ТУ 6-10-1539-76.
2. Меточный знак - маркировать точкой Ø1,2-0,6, зеленой эмалью ЭП-572 ТУ 6-10-1539-76
- 3.\* Зона не пригодная для изгиба и монтажа.

### Принципиальная схема



### Основные электрические параметры при $T_{окр.среды} = (25 \pm 10)^\circ C$

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма, не более	Режим измерения
Постоянный обратный ток, мкА	$I_{обр}$	5,0	$U_{обр} = 50$ В
Постоянное прямое напряжение, В	$U_{пр}$	1,1	$I_{пр} = 200$ мА
Заряд восстановления диода, пКл	$Q_{вос}$	400,0	при переключении с $I_{пр} = 50$ мА на $U_{обр.и} = 10$ В
Время обратного восстановления диода, нс	$t_{вос.обр}$	4,0	при переключении с $I_{пр} = 10$ мА на $U_{обр.и} = 10$ В при уровне обратного тока 2 мА
Общая емкость диода при нулевом смещении, пФ	$C_d$	4,0	
Импульсное прямое напряжение, В	$U_{пр.и}$	5,0	$I_{пр.и} = 2$ А
Дифференциальное сопротивление диода в открытом состоянии, Ом	$r_d$	5,0	$I_{пр} = 100$ мА
Тепловое сопротивление кристалл-корпус диода, град/Вт	$R_T$	200,0	